壁面に熱電対を配置したマイクロ流路デバイス

Microfluidic Device Having Thermocouples on Sidewall

豊田工業大学 柴田 真宏,山口 貴大, 熊谷 慎也, 佐々木 実 Toyota Technological Institute Masahiro Shibata, Takahiro Yamaguchi, Shinya Kumagai, Minoru Sasaki

I. はじめに

17p-PA1-7

マイクロ流路デバイスでは生体材料を扱うことが多い. 生体材料は僅かな温度変化でも、その機能が変わるため、 温度管理は重要である.流れの付近に熱電対を配置する ことで、局所的な温度を正確に測定できる.但し、流路 内部を顕微鏡観察するニーズがあるため、流路上部は透 明な膜を維持する方が良い.熱電対は不透明な金属膜か ら製作することになるため、流路上部を覆う平板に平面 リソグラフィによって製作すると、観察を阻害する.そ こで、熱電対を流路の垂直壁面に配置できれば、光学的 な観察と温度測定を同時に行うことが可能になる.ただ、 平面リソグラフィによる壁面加工の実現は難しい.本研 究では3次元フォトリソグラフィ技術[1]により製作・評 価したので報告する.

II. 結果

図1は、デバイス構造を表した模式図である.マイク ロ流路の上部は図示していないがカバーされており、流 れが流路外に漏れないようになっている.図の右側に示 されている熱電対は、測温部がデバイス上面にある.カ バーがあるため、流れと接することはない.図の左側に 示されている熱電対は、垂直壁を越えて金属線が繋がっ ており、測温部が壁面にあるため、流れに接する.この ため流れの温度測定が正確で、時間応答も良いことが期 待される.

図2(a)は製作したデバイスと,熱電対の配列である.3 本の縦線はPDMSで覆われたマイクロ流路である.熱電 対は流路の両側にあり,左側のグループは,流路壁面の 熱電対まで配線されたものであり,右側のグループは流 路から50µm離れた基板上面の熱電対に配線されている. 図2(b)は拡大図である.熱電対を形成する金属はCrとAl を使用した.図2(c)はさらに拡大したものである.コーナ ー上でも断線することなく,壁面上では2種類の金属が重 なり合って配線されている.

図3は,壁面と基板上面の熱電対の開放電圧の時間応答 をナノボルトメータ(Keithley, 2182A)で測定したもので ある.はじめはガスの流れがないため,流路内は室温で あり,流路周辺も同じ温度である.0秒の時点で,熱風を エアガン(Hakko 851-1 はんだ付け用ホットエアガン)で流 路内に流した.0秒より2つの熱電対の解放電圧は挙動が 変わり,流路壁面の熱電対はより高い電圧を示した.流 路壁面の熱電対が,流路から離れた基板上の熱電対より も,早く熱風を感知したことを示す.



図1.2種の熱電対を配置した流路と、流れの関係



図2. (a) 製作したマイクロ流路デバイスの外観
(b) 流路壁面の熱電対と流路の拡大図
(c)流路壁面の熱電対



謝辞

本研究の一部は文部科学省 私立大学戦略的研究基盤 形成支援事業(S1101028)、ナノテクノロジープラットフ ォームの支援を受けて実施された。

参考文献

 S. Kumagai, T. Yamamoto, H. Kubo, M. Sasaki, "3-D wiring across vertical sidewalls of Si photo cells for series connection and high voltage generation", Proc. MEMS 2012, pp.60-63.